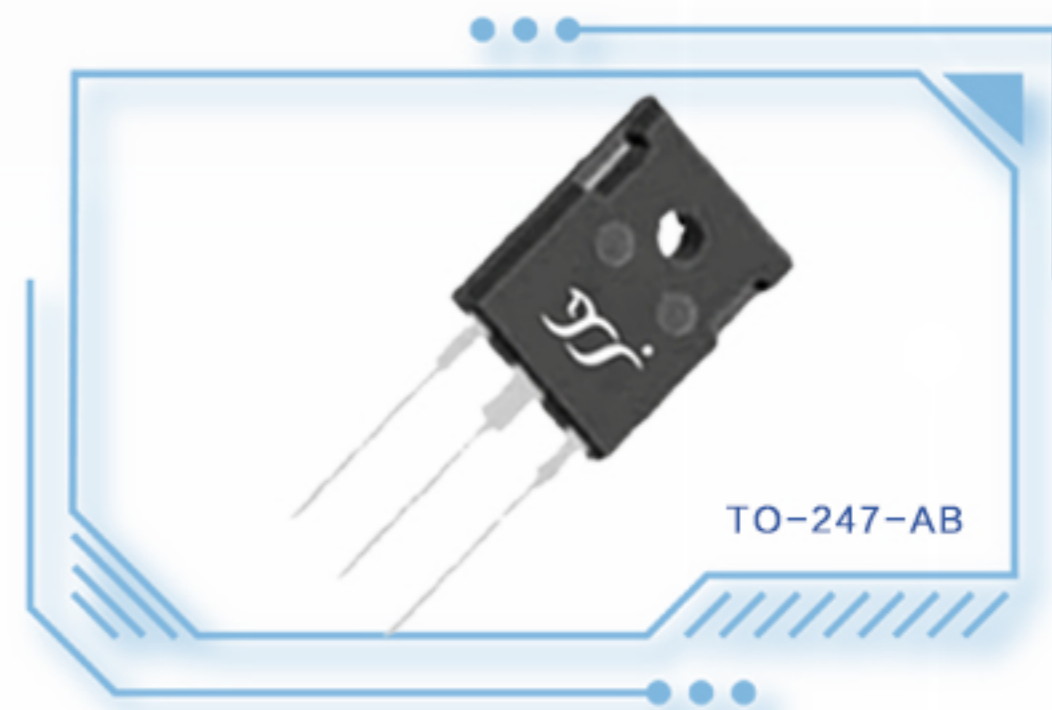
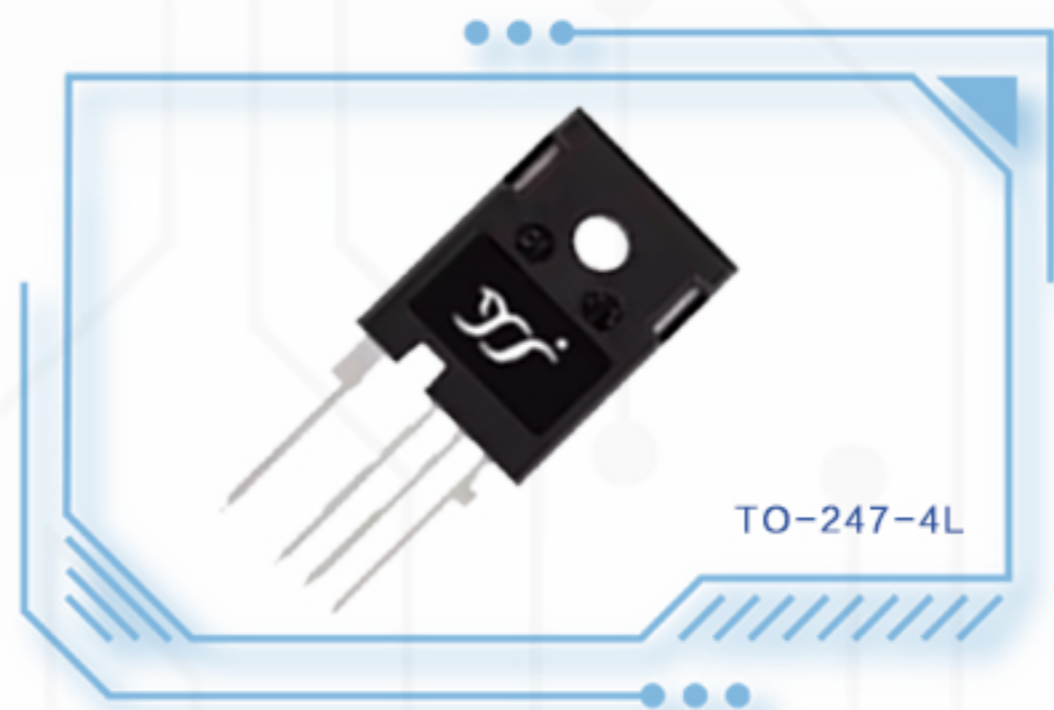


1200V 40mΩ 碳化硅MOSFET

产品介绍

2021年来PV逆变器市场进入高速发展期，对碳化硅功率器件的需求迅速增大。碳化硅二极管和MOSFET应用在诸如BOOST电路等应用中，因为第三代半导体材料带来的高频特性，可以提高系统的开关频率，从而可以优化整个系统的能耗和体积。我司碳化硅 MOSFET为匹配PV、EV行业客户需求，开关性能、通流能力以及产品可靠性可以对标行业最佳.不仅适用于常规开关应用，还满足控制要求高的高压高速开关应用，采用环保物料，符合RoHS标准。



产品特点

- 1.耐高温特性，工作温度（150° C）；单极性器件,开关速度快，损耗低，适用于高压，高频的应用条件；
- 2.采用先进的减薄工艺，使SiC MOSFET具有优异的低阻抗特性，减小器件能量损耗；
- 3.TO247AB，TO247-4L等多种封装形式可选；
- 4.通过行业严苛的可靠性认证，包括大批量的HTRB、HTGB测试和HV-H3TRB测试。

电性参数

Product	Blocking Voltage V _{DSS}	Current Rating ID	Generation	R _{dson} (mΩ) at 25°C @V _{GS} =20V	Gate Charge Total Q _g (nC)	Output Capacitance C _{oss} (pF)	Total Power Dissipation P _{tot} (W)	Thermal resistance R _{thJ-C} (°C/W)	Maximum Junction Temperature (°C)	Package
YJD212040NCFG1	1200V	63A	Gen1	40	120	141	298	0.42	150	TO247-4L
YJD212040NCTG1	1200V	63A	Gen1	40	120	141	298	0.42	150	TO247AB

更多产品详见官网

应用领域



光伏逆变器



EV应用



充电桩



电源